

Mg Si_x

V-2296

1910

Mg₂Si, Mg₃Sb₂, Mg Cu₂, CrSb ugr
(Hg - Hg)

Schimppff H.,

Z. phys. Chem., 1910, 71, 257

A₁, B

cert q.k

IX 2289

1936

Al_2Si ; Mg_2Si , Mg_3 , MgO

(alk in soln, in sl).

Hume - Rothery ~~W.~~ W.,

Philos. Mag., 1936, 22, 1013-47



Cut, 1937. 1674⁷

IX 1324

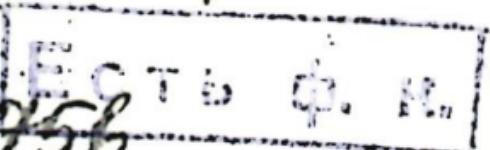
1949

Ba₃Bi₂; Ba₃Sn₂; Ca₂Pb, BaPb, BaSn₃,
Ba₂Sn; BaSn₃; Ca₂Sn; CaSn₃; CaSi;
CaSia; Mg₂Si (Mf)

Kubashevskii O., Villa H.,

Z. Electrochim., 1949, 53, 32-40

c.t., 1949, 52758

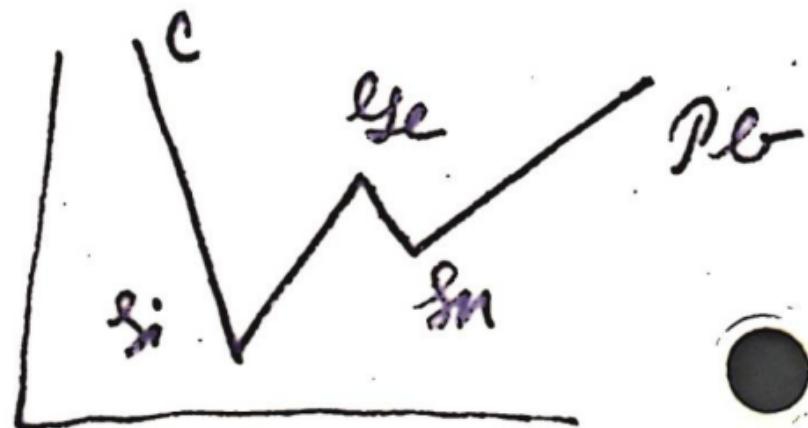


III

БИ-Х-2840 | 1953
Мукарев С.А.,

$Mg_2 Si$	Василькова Н.В.
$Mg_2 Ge$	Вестник МГУ, 1953, №2, 115-120.
$Mg_2 Sn$	
$Mg_2 Pb$	Изление вторичной неподвиж. на природе сед. Технол. Mg с C, Si, Ge, Sn, Pb образован
	(кандидат наук диссертация Василькова)

- $Mg_2Si = 82\,800 \pm 2\,100$
 $Mg_2Ge = -50,500 \pm 1700$
 $Mg_2Sn = -59\,600 \pm 800$
 $Mg_2Pb = -23\,400 \pm 1300$
 $MgC_2 = +21\,000 \pm 5\,000$



Mg-coed.

Hebb (1954)

Mg₂Si

Nelson J.T.

1955

Mg₂Si

Amer. Jour. of Physics 1955, Vol. 23
390,

Эксперимент и оценка
свойств Mg₂Si и Mg₂Si

VII 4386

1955

Mg₃Si₂, MoSi₂, VSi₂, NbSi₂

(Kp. emp.)

Parthe E., Nowotny H., Schmid H.,

Monatsh. Chem., 1955, 86, N3, 385-396

Mr

ee76 q-k

1962

Mg₂Si Thermal decomposition of magnesium silicide. K. Grjotheim, O. Herstad, S. Petrucci, R. Skarbo, and J. Toguri (Tech. Univ. Norway, Trondheim). *Rev. Chim., Acad. Rep. Populaire Roumaine* 7(1), 217-23(1962)(in English). In order to clarify Mg₂Si formation in molten and solid alloys, and to understand the kinetics of the thermal redn. of Mg compds. with Si, the reaction of Mg₂Si(s) → 2Mg(g) + Si(s) was studied at 858-1055°. Detn. of the Mg dissoen. pressure was used to obtain the data required. The Mg₂Si was prep'd. by heating a mixt. of Si and Mg 3:1 at 600° (8 hrs.) in Ar, then at 700° (2 hrs.) to remove the unreacted Mg. The carrier gas was 99.94% Ar. A series of equil. pressure detns. at different flow rates (25-213 cc./min.) at const. temp. (977 ± 2°) resulted in an approx. const. pressure in the interval 40-160 cc./min., its value being ~31 mm. A straight line resulted by plotting the equil. vapor pressure values vs. 1/T, corresponding to the equation log P = -(8500/T) + 8.29; no discontinuity could be inferred with certainty from these results, indicating that the Si activity is not far from unity at >950°. The heat of formation of Mg₂Si from the solid elements was $\Delta H_{298}^{\circ} = -10.2 \pm 1.5$ kcal./mole and the standard entropy of formation $\Delta S_{298}^{\circ} = +2.22 \pm 2.00$ cal./mole-degree. The heat of dissocn. at 900° was 15.600 ± 1.500 kcal./mole. The large enthalpy of dissocn. indicated a high bond strength in the Mg₂Si. M. Ben Elieser

C.A. 1963

59.3

2382 ef

1963

Mg₂Si

V 10 Б396. Термическое разложение силицида магния.
Grotheim K., Herstad O., Petrucci S., Skatbo R., Toguri J. The thermal decomposition of magnesium silicide. «Rev. chim. Acad. RPR», 1962, 7, № 1, 217—223 (англ.)

Методом уноса, описанным ранее (РЖХим, 1961, 24Б446), измерено давление диссоциации Mg₂Si. Показано, что в интервале т-р 858—950° диссоциация Mg₂Si протекает согласно ур-нию Mg₂Si (тв.) = 2Mg (газ) + Si (тв.). Равновесное давление пара магния в интервале т-р 858—1055° может быть представлено ур-нием $\lg P$ (мм рт. ст.) = $-8500/T + 8,29$. Отсюда для теплоты образования и стандартной энтропии образования Mg₂Si из элементов в твердом состоянии найдено $\Delta H_{298}^{\circ} = -10,2$ ккал и $\Delta S_{298}^{\circ} = 2,22$ энтр. ед. соответственно.

B. Байбуз

Mg-Ca-Si
Mg₂Si

1963

Ребников Ч. В., Михайловский
А. С.

ΔHf " "
δ₂₅₈
B4P-9.752-1K

Чб. В 43. Увей. чистоалюминий
1963, №1, 95.

Пузырьковое давление паров
магния над твердым алю-
минием и синтез алюминия
и Mg-Ca-●-Si.

Х. 1984.2

MgSi

1963

10Б391. Условия восстановления окислов магния кремнием при получении магниевых лигатур. Рябчиков И. В., Микулинский А. С. «Изв. АН СССР. Отд. техн. н. Металлургия и горн. дело», 1963, № 2, 9—12

При использовании экспериментально найденной величины энтропии силицида магния выполнен термодинамич. анализ р-ции восстановления окиси магния кремнием при получении сплавов $Mg-Si$ и $Mg-Ca-Si$. До $1900-1950^{\circ} K$ условия восстановления MgO до силицида являются более благоприятными, чем до парообразного магния. Выше этих т-р р-ции, протекающие с образованием парообразного магния, должны получить большее развитие. Условия для диссоциации силицида магния несколько благоприятнее, чем для процесса его образования. Рассчитана активность и конц-ия магния в сплаве в предположении, что жидкий силицид магния является р-ром переменного состава. При восстановлении окиси магния кремнием можно получить сплав, содержащий до 1,7 вес. % Mg. В присутствии CaO возможно увеличение Mg в сплаве до 9,2 вес. %. Реферат авторов

х-1064.10

IX-3619

1964

Mg₂Si, Mg₂Ge, Mg₂Sn (Kspur. copper
upon boric P)

Cannon P., Conlin E.T.

Science, 1964, 145, N° 3627, 487-489
^{31'}

Tour., Me



corr. Q.K.

IX-173

~~1964~~

1964

Mg₂Si, Mg₂Sn, Mg₂Pb (ΔFf)

~~Чаоу Чжан-хе~~

Chou Yuan-hsi

Цзиньшу свободо.

Acta metallurg

sinica, 1964, 7, N₃, 327-31.

Свободная энергия образования

Mg₂Si, Mg₂Pb, Mg₂Sn.

RM., 1965, 4428

M 15, 4428 φ. 16

Mg_2Si

B9-IX-2656

1964

Thermodynamic properties of magnesium disilicide. G. M. Lukashenko and V. N. Eremenko. *Zh. Neorgan. Khim.* 9(10), 2295-6(1964)(Russ). Compds. of Mg and Si were prep'd. from pure metals in an arc furnace. Emf. of the concn. galvanic cell $Mg_{(s)} | KCl-LiCl + 1\% MgCl_2 | (Mg_2Si + Si)_{(s)}$ was measured at 400-600°. Three different compds. (57.5, 62.5, and 67.5 wt. % of Si) were used and the results were treated by the least sqs. method. Plot of emf. vs. temp. was linear. For the reaction $2Mg_{(s)} + Si_{(s)} = Mg_2Si_{(s)}$, $\Delta H_{2980K}^{\circ} = -18,950 \text{ cal./mole}$ and $\Delta S_{2980K}^{\circ} = -6.69 \text{ cal./mole-degree}$. V. Dvorak

ΔH°
298

ΔS°
298

C.A. 1965. 62.2
1126 f

Mg_2Si

БД-IX-2656.

1964

4 Б426. Термодинамические свойства силицида магния. Лукашенко Г. М., Еременко В. Н. «Ж. неорганич. химии», 1964, 9, № 10, 2295—2296

Методом измерения э. д. с. гальванич. цепей вида $Mg(\text{тв.})|KCl-LiCl+1\%MgCl_2|Mg_2Si+Si(\text{тв.})$ определены изобарно-изотермич. потенциал ΔZ , энтропия и теплота образования силицида магния. Стандартные значения теплоты и энтропии образования равны —18950 кал/моль и —6,69 энтр. ед. Зависимость ΔZ образования Mg_2Si от т-ры в области 400—600° передается ур-нием $\Delta Z = -19150 + 7,065 \cdot T$ кал/моль.

$$\Delta H_f = -18950 \text{ кал/сесов} =$$
$$= -26430 \text{ дж/с. един.}$$

х. 1965.4

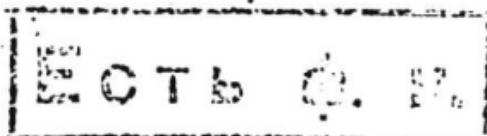
TX 3754 1964

Mg₂Si, Mg₂Ge, Mg₂Sn
(Tr)

Musgrave M. J. P.

Proc. Phys. Soc., 1964, 84, 585-590

T

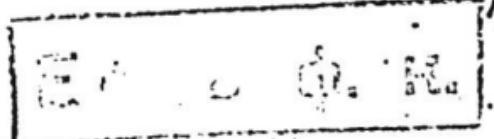


VI 3939

1965

Mg₂Si, Mg₂Sn, Mg₂Pb, CuI, CdTe и
CaF₂; NaCl; ZnTe (Tm)

Tsayeb B.M., Krestovskiyev A.H.,
Tsarevva N.N.,
Докт. АН ССР, 1965, 161, 629-632



Б ЛСГБ Ф. К.

Mg₂Si (cig.) YANAF

1965

T. ph.

298-4000°K

Mg₂Si (kp.)

YANAF

1985

T. q.s.

298 - 2500°K

ВФ - 1407 - IX

1965

Mg₂Si

20 Б348. Термоемкость Mg₂Si от 12 до 300° К.
~~Маннхен W., Яакоби Г. Die Molwärme des Mg₂Si
von 12° bis 300° K. «Z. Naturforsch.», 1965, 20b, № 2,
178—179 (нем.)~~

Экспериментально измерены C_p (кал/град моль) от 12 до 300° К для 2 образцов Mg₂Si свободного от H₂ (I) и содержащего 1,72 мл H₂/моль (при норм. условиях) (II). Полученные данные представлены графически и табулированы. Авторы отмечают отсутствие разницы в кривых C_p-T для образцов I и II. На основании данных, полученных для образца I, рассчитана S_{298}° (Mg₂Si) = 19.8 ± 0,1 энтр. ед. Приведено описание используемого калориметра.

И. Волкова

X · 1965 · 20

BQ - 1160 - IX

1966

Mg₂Si

Mg₂Ge

Mg₂Sn

Mg₂Pb

Sublimation in the intermetallic series Mg₂Si, Mg₂Ge, Mg₂Sn, and Mg₂Pb. H. J. Caulfield and D. E. Hudson (Iowa State Univ., Ames). *Solid State Commun.* 4(6), 299-301(1966)(Eng). The sublimation of Mg₂Si, Mg₂Ge, Mg₂Sn, and Mg₂Pb was studied by mass spectrometric observation of the vapor effusing from a Knudsen cell. Analysis of the temp. dependence of the partial pressure of Mg was used to obtain ΔH_{Mg} . The values of ΔH_{Mg} reported in this work are shown to correlate with the known m.ps. of the various compds. and to support metallic interpretation of the high cond. of Mg₂Pb.

RCYZ

+3

C.A. 1966. 65.5
6841d

☒

ВР - 1160 - IX

1966

Mg₂Si

Mg₂Ge

Mg₂Sn

Mg₂Pb

Д 1 Е297. Сублимация интерметаллических соединений Mg₂Si, Mg₂Ge, Mg₂Sn и Mg₂Pb. Caulfield H. J., Hudson D. E. Sublimation in the intermetallic series Mg₂Si, Mg₂Ge Mg₂Sn and Mg₂Pb. «Solid. State Communs», 1966, 4, № 6, 299—301 (англ.; рез. нем.)

Масс-спектрометр и ячейка Кнудсена использованы для определения (в интервале 550—610° K) парциальной молярной теплоты Mg (ΔH_{Mg}) в соединениях Mg₂X (X=Si, Ge, Sn, Pb). Измерения проводились для изотопа Mg²⁴. Других состояний Mg, кроме атомарного, в паровой фазе не обнаружено. Из температурной зависимости упругости пара Mg найдены следующие значения ΔH_{Mg} : 44,4±0,4; 53,8±0,9; 43,9±1,0; 33,7±0,6 ккал/моль, соответственно, для Mg₂Si, Mg₂Ge,



+3



1967. 18

Mg_2Sn и Mg_2Pb . Многочисленными повторными опытами показано, что систематич. изменений величин ΔH_{Mg} при изменении площади отверстия ячейки Кнудсена, навески образца и числа предшествующих опытов не наблюдается. Найдена корреляция между величинами ΔH_{Mg} и т-рами плавления в исследованном ряду соединений. Резкое уменьшение ΔH_{Mg} при переходе от Mg_2Sn к Mg_2Pb объясняется более ярко выраженными металлич. свойствами Mg_2Pb .

В. Алексеев

Mg₃Sn₂; Mg₂Li; Mg₂Ge; VI 6839
MgSiO₄ 1966

ZnSb; Mn₃i. (Шершнеген. Св-ва)

Бреческо В.Н.; Мухамеджеко Т.М.,

Хим. свидг в неупорядочен-

ых, ИИ-Т физики и близкого

мира. Неупорядочен. АН БССР

1966, ИИ-52

III

С.А. 1967

Mg₂Si

1966.

У5 Б774. Объемные изменения при плавлении соединений со структурой антифлюорита. Глазов В. М., Глаголова Н. Н., Романцева Л. А. «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1966, 2, № 10, 1737—1740

Исследована плотность соединений Mg_2Si , Mg_2Sn и Mg_2Pb в широком интервале т-р в тв. и жидкком состояниях. В тв. состоянии при т. пл. плотности Mg_2Si и Mg_2Sn равны 1,84 и 3,45 г/см³; в жидкком состоянии при той же т-ре плотности Mg_2Si ; Mg_2Sn и Mg_2Pb равны соотв. 2,27; 3,52 и 5,20 г/см³. Плотность в тв. состоянии измеряли дилатометрич. методом, в жидкком состоянии методом

X · 1967 · 5

№

гидростатич. взвешивания эталона из монокристаллов W и Mo, погруженных в исследуемый расплав. Все измерения в жидком состоянии производились под слоем флюса LiCl+KCl или карналлита. Показано, что при плавлении соединений Mg_2B^{IV} происходит увеличение плотности, связанное с ростом координационного числа при плавлении в результате изменения характера хим. связи от преимущественно ковалентного в тв. фазе к металлич. в жидкой фазе.

Реферат авторов

Mg₂Si
Gp.

ВФ 991-IX

1966

) 4 Б501. К мольной теплоемкости Mg₂Si. Jacobi G.
Zur Molwärme des Mg₂Si. «Z. Naturforsch.», 1966, 21b,
№ 5, 488—489 (нем.)

Из измеренной ранее (РЖХим, 1965, 20Б348) теплоемкости C_p Mg₂Si вычислены по ф-ле Нернста—Линдемана значения C_v в интервале 14—150° К, из к-рых найдены характеристич. т-ры θ_D . Т-рная зависимость θ_D характерна для полупроводников. Для ур-ния $C_v = aT^3 + \gamma T$ коэф. электронной теплоемкости $\gamma = 6,4 \cdot 10^{-4}$ кал/град²·моль; эта величина сравниена с γ для др. интерметаллич. соединений с решеткой флуорита. Величины C_p , C_v , $C_E = \gamma T$, $C(\text{реш.}) = aT^3$ и θ_D табулированы в интервале 14—150° К (шаг 4—10°). В. Колесов

Х. 1967. 4

Mg₂Si

B9-991-IX

1966

Molar heat(capacity) of Mg₂Si. G. Jacobi. Z. Naturforsch., b 21(5), 488-9(1966)(Ger). The variation of the Debye characteristic temperature with abs. temp. at 0-100°K. indicated that Mg₂Si should possess the elec. characteristics of a semiconductor. The coeff. of electronic heat capacity (0-16°K.) for Mg₂Si is 6.4×10^{-4} cal/.°K.² mole, which agrees with the values found for similar intermetallic compds. David H. DeVoe

C.A. 1966. 65. 8
114318

IX-3184

Mg₂SiO₄, Mg₂SiO₄, CaMg₂SiO₄,
 Ca₂Mg₂Si₂O₆, Ca₂Mg₂Si₂O₆, Ca₃Mg₂Si₂O₈,
 Mg₂Al₂Si₂O₈, Mg₂Al₂Si₂O₈ (δ₃)

1966

Henderson D., Taylor J.

J. Iron. and Steel Inst., 1966, 204, N1, 39-73 (with),
 Thermodynamic properties in the CaO-MgO-SiO₂ and
 MgO-Al₂O₃-SiO₂ systems

PLT KUM, 1967
 86575

V M Q

~~TK~~ - 1183

1966

Mg₂SiO₄, Mg₂SiO₄, CaMg Si₂O₅,
CaMg Si₂O₆, Ca₂Mg Si₂O₇, Ca₃Mg Si₂O₈
(s.Gf)

Henderson D., Taylor J.,
J. Iron Steel Inst. (London),
1966, 209, pt. 41-45

CA, 1966, 64, N10, 13447c M

1966

VI-4515

Mg₂Si, Mg₂Ge, Mg₂Sn, Ca₂Si,
Ca₂Ge, Ca₂Sn, Po, Am, ZnTe, HgSe, HgTe
(ΔS° 298)

Шарифов К.А., Разови Ю.Р.

Ж.Физ.Химии, 1966, 40/6/, 1255-8.

Расчет энтропии твердых неорганич.
соединений.

Be,

F

CA, 1966, 9833e

1407

Mg₂Si
Mg₂Ge,
Mg₂Sn, Mg₂Pb
(р, дж)

20 Б760. Исследование термических свойств полупроводников групп II—IV. Решеточные теплоемкости и свободные энергии образования. Теплоемкость Mg₂Si от 15 до 300° К. Gerstein B. C., Jelinek F. J., Habenschuss M., Shickell W. D.; Mullaly J. R., Chung P. L. Thermal study of groups II—IV semiconductors of formation. Heat capacity of Mg₂Si from 15°—300° К. «J. Chem. Phys.», 1967, 47, № 6, 2109—2115 (англ.)

Измерена теплоемкость Mg₂Si от 15 до 300° К. Разброс эксперим. данных от сглаженной кривой составляет 20% ниже 30° К и меньше 0,5% выше 30° К. Найдены следующие значения термодинамич. функций при 298,15° К: $S_{298,15^\circ} = 75,799 \text{ дж/град.г форм. массы}$; $(G_{298,15^\circ} - H_0^\circ)/T = 33,830 \text{ дж/град.г форм. массы}$, $(H_{298,15^\circ} - H_0^\circ)/T = 41,969 \text{ дж/град.г форм. массы}$. Значе-

(t3)

Х. 1968.

20



ния решеточной теплоемкости, дебаевской т-ры и термодинамич. функций табулированы. Используя литературные данные авторы показали, что ΔH° (испарения) Mg_2Si , рассчитанные по 2-му и 3-му законам, удовлетворительно согласуются между собой. Для Mg_2Si , Mg_2Ge и Mg_2Sn приведен график зависимости $\theta_D(T)/\theta_D(0)$ от $T/0$ (где θ — дебаевская т-ра при $0^\circ K$) для того, чтобы предсказать энтропию Mg_2Pb при $273^\circ K$. Рассчитаны стандартные свободные энергии образования при $298,15^\circ K$ для Mg_2Si , Mg_2Ge , Mg_2Sn и Mg_2Pb и сравнены с литературными. Обсуждается устойчивость соединений относительно элементов.

В. Воробьев

1967

Mg₂Si

(C_p)

6 E830. Термодинамические исследования полупроводников II—IV групп. Решеточные теплоемкости и свободные энергии образования. Теплоемкость Mg₂Si от 15 до 300° K. Getstein B. C., Jelinek F. J., Habenschuss M., Shickell W. D., Mullaly J. R., Chung P. L. Thermal study of groups II—IV semiconductors. Lattice heat capacities and free energies of formation. Heat capacity of Mg₂Si from 15°—300° K. «J. Chem. Phys.», 1967, 47, № 6, 2109—2115 (англ.)

Работа является частью программы термодинамич. и кристаллодинамич. изучения полупроводнико. соединений II—IV групп. Полученные для C_p значения и вычислен-

09.1968. 68

18

ные значения C_v , θ_D и термодинамич. ф-ций табулированы. Вычислены свободные энергии образования соединений Mg_2Si , Mg_2Ge , Mg_2Sn , Mg_2Pb . Они, однако, расходятся с другими опубликованными данными. Сделана попытка построить одинаковую для всех соединений приведенную кривую зависимости $\theta_D(T)/\theta$ от T/θ , где θ — т-ра Дебая при 0° К. Кривые не вполне совпадают, но позволяют все же определять с точностью до 15% термодинамич. ф-ции еще не исследованных соединений.

Библ. 21.

А. Кикони

1967

103343b Thermal study of Groups II-IV semiconductors. Lattice heat capacities and free energies of formation. Heat capacity of Mg_2Si from 15 to 300°K. B. C. Gerstein, F. J. Jelinek, M. Habenschuss, W. D. Shickell, J. R. Mullaly, and P. L. Chung (Iowa State Univ., Ames). *J. Chem. Phys.* 47(6), 2109-15(1967)Eng). The heat capacity of Mg_2Si has been measured from 15 to 300°K., and the lattice heat capacity, Debye temp., and thermodynamic functions have been tabulated. The following values were found for the thermodynamic functions at 298.15°K: $S^{\circ}_{298.15} = 75.799 \text{ j. (degree)}^{-1}$, $-(G^{\circ}_{298.15} - H^{\circ}_0)/T = 33.830 \text{ j. (degree)}^{-1}$. A third-law "reasonability check" was made on a recently published heat of sublimation. A reduced temp. plot of Mg_2Si , Mg_2Ge , and Mg_2Sn using the 0°K. Debye temp. as the reducing parameter is used to predict the entropy of Mg_2Pb at 273°K. The standard free energies of formation at 298°K. are calcd. for Mg_2Si , Mg_2Ge , Mg_2Sn , and Mg_2Pb and compared with previously published results. The relative stabilities of the compds. with respect to the elements are discussed.

RCJQ

C.A-1967. 07.22

II

Bp - 496 - IX

1968

Mg₂Si^{IX}

Geffken R., Miller E.

Trans. Met. Soc. A.M.M.S.
242 (11), 2323

T_m

Bp - 3363 - IX

(c.u. Mg₂Ge) !

V 6365

1968

InSb, InTe, InS₂, In₂Te₃, GaS₂, CdSb, GaAs,
CdSb, Mg₂Si, Mg₂Sn, Mg₂Pb, SnTe, GeTe,
PbTe, PbSe, Sb₂Te₃, Bi₂Te₃ (dHm, dSm)

Мечех Б. Т., Семенкович Л. С.:

Изв. вуз. Химия, 1968, 42(3),
672-674

СССР, 1968, 59, № 6, 22713м

5

Бер IX-7340

2 Б1077. Изучение термической диссоциации Mg_2Si .
Большаков К. А., Бульянков Н. А., Сахаров В. В., Желанкин В. И., Шаронов Б. Н.
«Изв. АН СССР. Неорган. материалы», 1970, 6, № 9,
1602—1606

Изучен процесс термич. разложения Mg_2Si , обладающего сложной кинетикой испарения. Определены т-рные зависимости параметров, определяющих скорость процесса термич. разложения — линейной константы скорости и коэф. массопереноса через слой продукта разложения. В результате сравнения испарения с открытой поверхности и из эфузионного отверстия показано, что коэф. Лэнгмюра намного меньше единицы ($\alpha \approx 0,03$). В интервале т-р 660—720° эфузионным методом измерено давл. диссоциации Mg_2Si . Значения энталпии и энтропии диссоциации Mg_2Si подтверждены термодинамич. расчетом.

Автореферат

Mg Si

Рдингоуз;

ДН

X. 1971. 2

1970

Mg_xSi

4 Б848. Давление пара и термическая диссоциация соединений Mg₂BiV. Никитин Е. Н., Розыев Н. «Ж. прикл. химии», 1970, 43, № 9, 2093—2095

Эффузионным методом Кнудсена при т-рах 900—1200° К измерено давл. паров над тв. Mg₂Si (I), Mg₂Ge (II), Mg₂Sn (III) и Mg₂Pb (IV). Термич. разложение соединений протекало по р-ции Mg₂X (тв.) \rightleftharpoons 2Mg (газ) + X (тв.). Наблюдавшаяся т-рная зависимость давл. паров описывалась ур-ием $\lg P = -A/T + B\lg T$. Найдены след. значения теплот испарения (ккал/моль): I 44,4 (при 1100° К), II 55,7 (при 1100° К), III 41,2 (при 1000° К), IV 26,6 (при 1000° К). Полученные результаты согласуются с данными работы (РЖХим, 1967, 6Б572).

Н. А. Попов

+ 3

ΔH_v

x. 1970.

У



Mg₂Si

34932y Vapor pressure and thermal dissociation of Mg₂BIV compounds. Nikitin, E. N.; Rozyev, N. (USSR). *Zh. Prikl. Khim. (Leningrad)* 1970, 43(9), 2093-5 (Russ). The vapor pressures and heats of dissociation of Mg₂Ge, Mg₂Si, Mg₂Sn, and Mg₂Pb were determined in Knudsen cells at 950-1200°K and the results correlated by the linear equation: $\log P = \Delta H_{\text{dis}} / 4.575T + \Delta C_p / 2 \log T$, where P is the vapor pressure (atm); ΔH_{dis} , the heat of dissociation under standard conditions (kcal/mole); ΔC_p , the changing heat capacity during total conversion; and T , the temp. (°K). The experiments for synthesis and measurement were performed with highly purified materials in a specially designed apparatus operating at 10^{-5} torr with continuous and automatic measurement. Purified Mg was used as a standard. Equations were developed for calculating the change of P and the equilibrium P within the cells at various temperatures. The calculated and determined values are in satisfactory agreement. The mechanism of dissociation of these compounds is described. The value of ΔH_{dis} was derived by calculation from the slope of each straight line which resulted from the $\log P - 1/T \cdot 10^4$ plot. The values of ΔH_{dis} are in descending order from Mg₂Ge to Mg₂Pb, as listed above, whereas the values of P are in ascending order.

L. U. Franklin

C.A. 1971. 74: 8

1970

Mg Si

YANAF

1971

(Crystal) 100 - 2500°K $\text{H}_{\alpha\beta\gamma}$

(Liquid) 100 - 4000°K

1960

Mg₂Si

89-18-317

1971

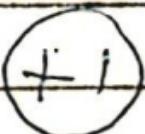
(91970h) Improved direct calorimetric method. Enthalpy of formation of the phases manganese silicide Mg₂Si and magnesium germanide Mg₂Ge. Blachnik, Roger; Kunze, D.; Schneider, Armin (Anorg.-Chem. Inst., Tech. Univ. Clausthal, Clausthal, Ger.). *Metall* 1971, 25(2), 119-21 (Ger). The calorimeter used by Kubaschewski and Dench was modified in 4 ways, mainly by the addn. of a 2nd heating element. In use the ignition heater was turned on and the temp. rise obsd. When a sudden increase occurred the heater was shut off and the temp. rise plotted to its max. A comparison was made on a blank run by providing heat to match that produced by the sample until the same max. temp. was reached. By making 3 comparison runs a good match in the curves was obtained. An accuracy of +0.2 to $\pm 0.3\%$ was achieved. The procedure was checked by detg. the formation enthalpy of Mg₂Si and Mg₂Ge. The results were 7.1 ± 0.9 kcal/g atom for Mg₂Si and 9.6 ± 0.5 for Mg₂Ge.

9 references.

C. E. Macfarlane

C.I. 1971

84.18



1972

Mg₂Si

24913r Obtaining vapor pressure evaluated by Knudsen and
boiling point methods for magnesium compounds. Agabaev,
Ch.; Rozyev, N. (Fiz.-Tekh. Inst., Ashkhabad, USSR). Izv.

Mg₂Ge

Akad. Nauk Turkmen. SSR, Ser. Fiz.-Tekh., Khim. Geol. Nauk
1972, (2), 89-92 (Russ). Exptl. data on the vapor pressure of
Mg₂B⁴, where B⁴ is Si, Ge, Sn, or Pb, obtained by the Knudsen
method and the b.p. method are compared and analyzed. The
deficiencies of the latter method are discussed.

Mg₂Sn

Mg₂Pb

(p)

(+3)

AT.

C.A. 1972

77.4

Algo Si

1973

Bavin T; et al.

vol. I; p. 451

298-1373 (el)
1373-2000 (x)

(coll. AG F-I)

Mg₂Si, Mg₂Ge, Mg₂Sn, IX-4887 1974.
Mg₂Pb, MnSi, Mn₂Si, CoSi,
(A6f; 4Hs, P). ММН

Розыев И., Абдасов У.

Узб. Академия наук ССР. Сер. физ.-техн.
хим.-мат. н., 1974, (3), 43-6.

Проблема термодинамических
свойств и термических свойств
иностранной полупроводниковой
литографии 10
С. А. 1974. № N 26. 177919 л. 5, А.р. ⑨

Mg₂Si

1976

Mg₂Ge

поли-
морф.

11 Е686. Полиморфизм при высоком давлении интерметаллических соединений Mg₂Si и Mg₂Ge. Дюжева Т. И., Кабалкина С. С., Верещагин Л. Ф. «Докл. АН СССР», 1976, 228, № 5, 1073—1075

Проведено рентгенографич. исследование образцов Mg₂Si и Mg₂Ge при давлениях до 100 кбар в интервале т-р 25—400°С и синтез новых модификаций при $P = 40 \div 75$ кбар и $T = 500 \div 1200$ °С с последующим рентгенографич. анализом продуктов синтеза. При комнатной т-ре при $P > 45$ кбар в Mg₂Ge и при $P > 60$ кбар в Mg₂Si происходит обратимый полиморфный переход первого рода. Метастабильные фазы Mg₂Ge II и Mg₂Si II синтезированы под давлением, а затем сохранены путем быстрого охлаждения и последующего снятия давления.

Е. С. Алексеев

Ф. 1976.

N18.

⊕ 17

1978

Mg₂Si

(Tm)

93: 32434f Structural features of metallic melts in Mg-B^{IV} systems (B^{IV} = silicon, germanium, tin, and lead). Glazov, V. M.; Pavlova, L. M.; Poyarkov, K. B. (Inst. Elektron. Tekh., Moscow, USSR). *Tezisy Nauchn. Soobshch. Vses. Konf. Str. Svoistvam Met. Shlakovvkh Rasplavov*, 3rd 1978, 2, 295-8 (Russ). Akad. Nauk SSSR. Ural. Nauchn. Tsentr: Sverdlovsk, USSR. The thermal stability of the Mg₂B^{IV} (B^{IV} = Si, Ge, Sn, or Pb) compds. at their m.ps. was investigated by using model descriptions of liquidus curves in an approxn. reflecting intermol. interactions in these systems. The dissocn. parameters at the m.ps. were calcd. for Mg₂Si, Mg₂Sn, Mg₂Ge, and Mg₂Pb. The calcd. and exptl. detd. data were compared. The Mg₂B^{IV}

compds. dissoc. to a high degree. This causes the structure peculiarities of corresponding melts.

(43)

(X)

CA 1980 93 n4

$Mg_2Si(K)$

1981

96: 150102f Thermodynamic properties of magnesium-silicon system. Rao, Y. K.; Belton, G. R. (Div. Metall. Eng., Univ. Washington, Seattle, WA 98195 USA). *Chem. Metall.--Tribute Carl Wagner, Proc. Symp.* 1981, 75-96 (Eng). Edited by Gokcen, Nev A. Metall. Soc. AIME: Warrendale, Pa. The activity-compn. relationships in the Mg-Si system were investigated by means of the electrochem. cell technique. The std. heat and entropy of formation of $Mg_2Si(s)$ from solid Mg and solid Si were deduced from the emf measurements in the 2-phase region.

$\Delta_f H$, $\Delta_f S$,

C.A. 1982, 96, N 18

Mg₂Si

1985

› 11 В6. Химия кремния и германия. XXXVI. Получение силицида магния спеканием из элементов. Beiträge zur Chemie des Siliciums und des Germaniums. XXXVI. Darstellung von Magnesiumsilicid aus den Elementen durch Sinterung. Fehér F., Ocklenburg F. J. «Z. anorg. und allg. Chem.», 1985, 530, № 11, 187—190 (нем.; рез. англ.)

Тонкий, гомогенный, серо-гол. порошкообразный Mg₂Si (I) получен в кол-ве 15—20 кг за одну операцию спеканием порошкообразных Mg и Si при т-ре 650° С в течение 24 ч в атмосфере Ar в специально сконструированном аппарате. Полученный I может быть использован для получения силанов методом к-тного разложения. Сообщ. XXXV см. Fehér T., Ocklenburg F. «Z. anorg. allg. Chem.», 1984, 515, 36. По резюме

X. 1986, 19, N 11

Mg₂Si

1986

17 Б3024. Электронная составляющая энтропии плавления в соединениях Mg₂B^{IV}. Глазов В. М., Кольцов В. Б., Курбатов В. А. «Термодинам. и материаловед. полупроводников. 3 Всес. конф., май, 1986. Тез. докл. Т. 2». М., 1986, 166—168

Методом переменного тока и переменного магнитного поля исследована т-риая зависимость эффекта Холла соединений Mg₂B^{IV}, где B^{IV}=Si, Ge, Sn и Pb (I—IV соотв.) в обл. плавления. Оценка изменений конц-ии носителей заряда и их подвижности указывают, что I—IV плавятся по типу полупроводник—металл. Этому соответствуют и аномальные изменения $\Delta_m S$ (4,93, 4,43, 3,63 и 3,77 э. е. для I—IV соотв.) и избыточные значения электронных составляющих энтропии плавления. Оценены вклады последних в $\Delta_m S$ соотв. 30, 28,9, 26,4 и 15% для I—IV.

А. С. Гузей

(73)

X. 1986, 19, N 17

Mg₂Be, Mg₂Sn,
Mg₂Pb

Mg₂Si

1986

19 Б3074. Фазовая диаграмма и термохимия системы Al—Mg—Si. Phase diagram and thermochemistry of the Al—Mg—Si system. Lüdecke D. «Z. Metallk.», 1986, 77, № 5, 278—283 (англ.; рез. нем.)

Проведен термодинамич. расчет фазовой диаграммы системы Al—Mg—Si и диаграмм составляющих бинарных систем. Расчетные и эксперим. данные удовлетворительно согласуются. Станд. энталпия образования Mg_2Si $\Delta H^{298} = -26,467$ Дж/г-атом, станд. энтропия образования $\Delta S^{298} = -6,66$ Дж/г-атом·К. Энталпия эвтектич. р-ции жидкость $\rightleftharpoons \text{Mg}_2\text{Si} + \text{Si}$ равна 32453 Дж/моль, что резко отличается от эксперим. данных — 20363 Дж/моль. Вклад параметра тройного взаимодействия в избыт. энергию Гиббса жидк. фазы м. б. представлен ур-нием $\Delta G^E = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot (45486,3 - 75 T)$. Л. Г. Титов

Diff, 1986;

X. 1986, 19, N 19

Mg₂Si

1986

18 Б3130. Термическое расширение и характеристики прочности межатомной связи в расплавах соединений Mg₂Si, Mg₂Sn, Mg₂Pb. Щеликов О. Д. «Термодинам. и материаловед. полупроводников. З Всес. конф., май, 1986. Тез. докл. Т. 2». М., 1986, 104

Термометрическим методом исследована т-рная зависимость уд. объемов соединений Mg₂Si, Mg₂Sn, Mg₂Pb в жидк. фазе. Полученные данные обработаны по методу наименьших квадратов. Получены интерполяц. ур-ния первой степени вида $1/V_{уд} = A + B/T - T_{пл}$. Рассчитаны коэф. термич. расширения исследованных расплавов соединений A₂B⁴ при различных т-рах. На основе данных по термич. расширению оценены характеристич. т-ры Дебая в жидк. фазе при т. пл каждого из исследованных соединений. Отмечено, что процесс плавления приводит к увеличению коэф. термич. расширения и уменьшению т-ры Дебая.

По резюме

*термические
расшир.*

(f2)
18

ж. 1986, 19, N 18

Mg₂Si 1990

Huang Guosheng, Li
Hongjie et al.

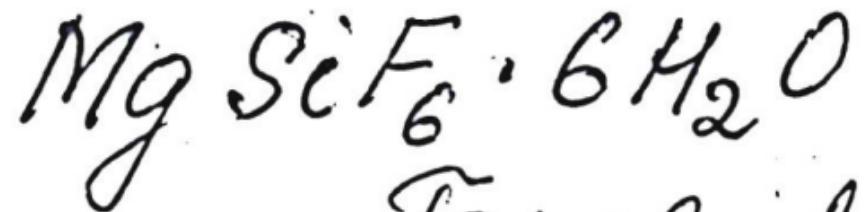
S₂₉₈,
Mn₂O₃
O₂/Fe₂O₃

Thermochim. acta.
1990. 173. C. 47 - 52.

(c.c., FeTi; ?)

No₂ Si 1990
Huang Guosheng, Li
Hongjie et al.

S₂₉₈,
memog
OBSERKU
Thermochim. Acta
1990, 173, C, 47-52.
(cu. FeTi; I)



1991

Торев И. В., Репров
И. Н. и др.

Физ. магн. свойс.
регистр.

Физ. свойс. магн.
(Магнитрэг) 1991.

33, №: С.2210-2212

Fe₃, Co SiF₆ · 6H₂O

Mg_{0.73}Si_{0.27} (cmelab) 01/1 38105 1995

123: 154009e The thermodynamic properties of a Mg_{0.73}Si_{0.27} alloy. Chekhovskoi, V. Ya.; Gusev, Yu. V. (Jt. Inst. High Temps., Moscow, Russia 127412). *High Temp. (Transl. of Teplofiz. Vys. Temp.)* 1995, 33(3), 378-81 (Eng). The results of measurements of enthalpy and av. heat capacity of the Mg_{0.73}Si_{0.27} alloy in the temp. range of 1100-1400 K in the regions of two-phase and molten states are presented. The compn. of the alloy has been detd. according to the enthalpy measurement data, thermog. data, and the data of x-ray diffraction and spectral anal. The results of measurements were approxd. by empirical equations. The enthalpy measurement errors in the two-phase region were 1.5-2%, and in the molten state 1%.

(H-H, Cp)

C.A. 1995, 123, N 12

Mg₂Si

1997

Fenzel, Harald; et al.,

J. Alloys Compd. 1997,
Gp. 15H 247(1-2), 31-42.

(all-Al-Mg-Si; I)

F: Mg-Si $Mg_{3}Si_x$

P: 1

2000

133:270004 A thermodynamic analysis of the Mg-Si system. Yan, Xin-Yan; Zhang, F.; Chang, Y. Department of Materials Science and Engineering, University of Wisconsin-Madison Madison, WI 53706, USA J. Phase Equilib., 21(4), 379-384 (English) 2000. A thermodn. description of the Mg-Si binary system was obtained. The term "thermodn. description" means that a set of thermodn. model parameters was obtained, on the basis of which the Mg-Si phase diagram as well as any of the single-phase thermodn. properties can be calcd. The

model parameters were obtained by optimization with exptl. phase equil. and thermodn. data available in the literature. The present description has fewer model parameters than the previous ones published in the literature, while the agreement of the model-calcd. thermodn. properties and phase boundaries with the exptl. data is as good or better than those of early descriptions. The computer program used to optimize the model parameters was WinPhaD, developed by CompuTherm LLC.